

半導體業	積體電路晶圓製造程序	包含經由物理氣相沈積、化學氣相沈積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子植入、氧化與熱處理等製程；僅從事晶圓封裝、磊晶、光罩製造、導線架製造、二極體製造及發光二極體製造等作業者或製程中確實未使用含氟溫室氣體者，非屬本公告之適用對象。	三、原（物）料、燃料使用量、產品產量或其他經中央主管機關認定之操作量，應依前一年度實際操作量計算之。但公告後始設立之排放源，其操作量以最大設計值為準。
薄膜電晶體液晶顯示器業	具備薄膜電晶體元件陣列基板或彩色濾光片生產程序	薄膜電晶體液晶顯示器之製程中，包含擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩色濾光片等程序；製程中確實使用含氟溫室氣體，亦屬本公告之適用對象。	
各行業	其他設備	全廠（場）化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達二·五萬公噸二氧化碳當量。	

行政院環境保護署公告

中華民國 105 年 1 月 7 日

環署溫字第 1040111710G 號

主 旨：廢止「公私場所應申報溫室氣體排放量之固定污染源」，並自即日生效。

依 據：「空氣污染防制法」第二十一條第一項。

公告事項：廢止「公私場所應申報溫室氣體排放量之固定污染源」。

署 長 魏國彥